

	<h2 style="color: red;">SI2323CDS-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2323CDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p> <p>Datenblätter:  SI2323CDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 216711 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2323CDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	216711 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Tc) 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1090pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2323CDS-T1-GE3TR

SI2323CDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2323CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2323CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2323CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2323CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p>	 <p>SI2323DDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p>SI2321DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.9A SOT-23</p>	 <p>SI2323DDS-T1-E3 Son SI2323DDS-T1-E3 Son</p>
 <p>SI2323CDS-T1-E3 VISHAY SI2323CDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2323 GMC SI2323 GMC</p>	 <p>SI2323DS VISHAY SI2323DS VISHAY</p>	 <p>SI2323D SI SI SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI2318DS	↔ SI2318DS-T1-E3	⇒ SI2318DS-T1-E3	D SI2318DS-T1-GE3	↔ SI2318DS-T1-GE3
↳ SI2319ADS-T1-GE3	⊛ SI2319C95TF	D SI2319CDS-T1-E3	⇒ SI2319CDS-T1-GE3	↔ SI2319CDS-T1-GE3
⊛ SI2319DDS-T1-GE3	↳ SI2319DS	⊛ SI2319DS-T1-E3	↔ SI2319DS-T1-E3	↔ SI2319DS-T1-GE3
D SI2319DS-T1-GE3	⊛ SI2320DS	↳ SI2320DS-T1-E3	⊛ SI2320DS-T1-GE3	↔ SI2321DS-T1-E3
⇒ SI2321DS-T1-E3	↔ SI2321DS-T1-GE3	⊛ SI2321DS-T1-GE3	↳ SI2323CDS-T1	↔ SI2323CDS-T1-E3
↔ SI2323CDS-T1-GE3	⇒ SI2323DDS-T1-E3	D SI2323DDS-T1-GE3	⊛ SI2323DDS-T1-GE3	↳ SI2323DS
⊛ SI2323DS-T1-E3	D SI2323DS-T1-E3	⇒ SI2323DS-T1-GE3	↔ SI2323DS-T1-GE3	↔ SI2324DS-T1-E3
↳ SI2324DS-T1-GE3	⊛ SI2324DS-T1-GE3	↔ SI2325DS-T1-E3	⇒ SI2325DS-T1-E3	↔ SI2325DS-T1-GE3
⊛ SI2325DS-T1-GE3	↳ SI2327DS-T1-E3	⊛ SI2327DS-T1-E3	D SI2327DS-T1-GE3	↔ SI2327DS-T1-GE3
↔ SI2328DS	⊛ SI2328DS-T1	↳ SI2328DS-T1-E3	⊛ SI2328DS-T1-E3	↔ SI2328DS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited